

### Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные диоды с барьером Шоттки. Предназначены для использования в гибридных схемах (ГС) с общей герметизацией, а также для сборки дискретных приборов.

### Обозначение технических условий

- АДКБ.432120.113 ТУ

### Корпусное исполнение

- бескорпусной вариант без кристаллодержателя (подложки) и без выводов

### Вид поставки, упаковка

- на общей пластине, неразделенной на кристаллы
- кристаллы в индивидуальной таре

**Таблица 1. Основные электрические параметры КДШ2102 при  $T_{ср} = 25 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$**

Наименование параметра, режим и условия измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Значение параметра		
		Мин.	Типовое	Макс.
Постоянный обратный ток диода, $(t_i \leq 300 \text{ мкс}, Q \geq 100)$ , мА $(U_{обр} = 40 \text{ В})$ КДШ2102А-5 $(U_{обр} = 60 \text{ В})$ КДШ2102Б-5 $(U_{обр} = 100 \text{ В})$ КДШ2102В-5	$I_{обр}$	-	-	0,5
Постоянное прямое напряжение диода $(I_{пр} = 2 \text{ А}, t_i \leq 300 \text{ мкс}, Q \geq 100)$ , В КДШ2102А-5 КДШ2102Б-5 КДШ2102В-5	$U_{пр}$	-	-	0,5 0,7 0,79
Пробивное напряжение диода $(I_{обр} = 10 \text{ мА}, t_i \leq 300 \text{ мкс}, Q \geq 100)$ , В КДШ2102А-5 КДШ2102Б-5 КДШ2102В-5	$U_{проб}$	40 60 100	- - -	- - -
Общая емкость диода $(U_{обр} = 5 \text{ В}, f = 1 \text{ МГц})$ , пФ	$C_d$	-	-	140

**Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КДШ2102**

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма		
		КДШ2102А-5	КДШ2102Б-5	КДШ2102В-5
Максимально допустимое обратное напряжение диода, В	$U_{обр, max}$	40	60	100
Максимально допустимое повторяющееся импульсное обратное напряжение диода ( $Q > 2$ , $f = 15$ Гц), В	$U_{обр, и, п, max}$	40	60	100
Максимально допустимый средний прямой ток диода ( $T_{cp} \leq 25$ °С, $f \geq 15$ Гц, $Q \geq 2$ ), А *	$I_{пр, ср, max}$	2	2	2
Максимально допустимый повторяющийся импульсный прямой ток диода ( $T_{cp} \leq 25$ °С, $Q \geq 2$ , $f \geq 15$ Гц), А *	$I_{пр, и, п, max}$	12	12	12
Максимально допустимый неповторяющийся импульсный прямой ток для единичной синусоидальной полуволны длительностью 5 мс ( $T_{cp} \leq 25$ °С), А	$I_{пр, и, нп, max}$	50	50	50
Максимально допустимая температура перехода, °С	$T_{пер, max}$	150	150	150
* При сборке в корпус КТ-28-1				



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>